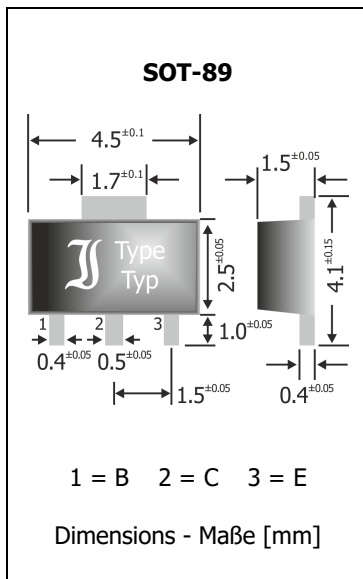


BCX53
SMD General Purpose PNP Transistors
SMD Universal-PNP-Transistoren

$I_C = -1 \text{ A}$
 $h_{FE} > 63/250$
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$

$V_{CE0} = -80 \text{ V}$
 $P_{tot} = 0.5 \text{ W}$

Version 2020-04-02

**Typical Applications**

Signal processing,
 Switching, Amplification
 Commercial grade ¹⁾

Features

High collector current
 Low saturation voltage
 Three current gain groups
 Compliant to RoHS, REACH,
 Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled
 Weight approx.
 Case material
 Solder & assembly conditions



tbd
 0.04 g
 UL 94V-0
 260°C/10s
 MSL = 1

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung,
 Schalten, Verstärken
 Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Hoher Kollektorstrom
 Niedrige Sättigungsspannung
 Drei Stromverstärkungsklassen
 Konform zu RoHS, REACH,
 Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle
 Gewicht ca.
 Gehäusematerial
 Löt- und Einbaubedingungen

Type Code	Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren
BCX53 = AH BCX53-10 = AK BCX53-16 = AL	BCX56

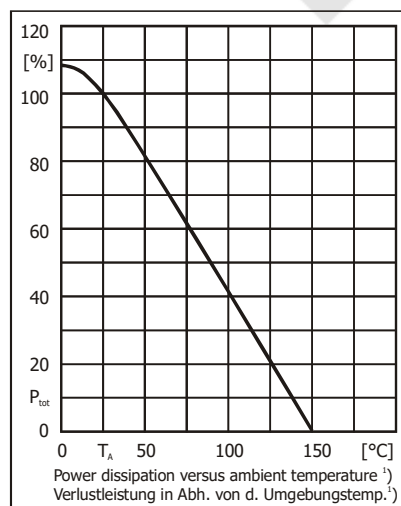
Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

			BCX53
Collector-Emitter-voltage – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- V_{CE0}	80 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	- V_{CBO}	100 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	- V_{EBO}	5 V
Power dissipation Verlustleistung	$T_S = 120^\circ\text{C}$	P_{tot}	0.5 W ³⁾
Collector current Kollektorstrom	DC	- I_C	1 A
Peak Collector current Kollektor-Spitzenstrom		- I_{CM}	2.0 A
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	-55...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	-55...+150°C

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
 2 $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$, wenn nicht anders angegeben
 3 Measured at collector terminal 2 – Gemessen am Kollektor-Anschluss 2

Characteristics
Kennwerte

		$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾					
- $V_{CE} = 2\text{ V}$, - $I_C = 5\text{ mA}$	all groups	h_{FE}	63	–	–
- $V_{CE} = 2\text{ V}$, - $I_C = 150\text{ mA}$	BCX53	h_{FE}	63	–	250
	BCX53-10	h_{FE}	63	–	160
	BCX53-16	h_{FE}	100	–	250
- $V_{CE} = 2\text{ V}$, - $I_C = 500\text{ mA}$	all groups	h_{FE}	25	–	–
Collector-Base breakdown voltage – Kollektor-Basis-Abbruch-Spannung					
- $I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$, (E open)		- $V_{(BR)CBO}$	100 V	–	–
Collector-Emitter breakdown voltage – Kollektor-Emitter-Abbruch-Spannung					
- $I_C = 10\text{ mA}$, (B open)		- $V_{(BR)CEO}$	80 V	–	–
Emitter-Base breakdown voltage – Emitter-Basis-Abbruch-Spannung					
- $I_E = 100\text{ }\mu\text{A}$, (C open)		- $V_{(BR)EBO}$	5 V	–	–
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung ¹⁾					
- $I_C = 500\text{ mA}$, - $I_B = 50\text{ mA}$		- V_{CEsat}	–	–	0.5 V
Base-Emitter-voltage – Basis-Emitter-Spannung ¹⁾					
- $V_{CE} = 2\text{ V}$, - $I_C = 500\text{ mA}$		- V_{BE}	–	–	1 V
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom					
- $V_{CB} = 30\text{ V}$, (E open)		- I_{CBO}	–	–	100 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom					
- $V_{EB} = 5\text{ V}$, (C open)		- I_{EBO}	–	–	100 nA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz					
- $V_{CE} = 5\text{ V}$, - $I_C = 10\text{ mA}$, $f = 100\text{ MHz}$		f_T	–	50 MHz	–
Typical thermal resistance junction to ambient Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung		R_{thA}	250 K/W ²⁾		



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

- 1 Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$
- 2 Mounted on P.C. board with 600 mm² copper pad at the collector terminal
 Montage auf Leiterplatte mit 600 mm² Kupferbelag (Löt-pad) am Kollektor-Anschluss